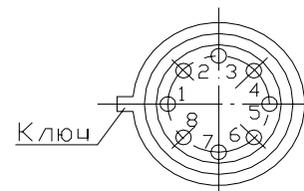


ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

при температуре (25 ± 5)°С

Схема расположения выводов



Нумерация выводов показана условно.
Ключ показывает начало отсчета выводов.
Масса не более 1,3 г.

Таблица назначения выводов

Обозначение выводов	Назначение выводов
1,5	Свободный
2	Коллектор VT1
3	База VT1
4	Эмиттер VT1
6	Эмиттер VT2
7	База VT2
8	Коллектор VT2

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка (Т_{нм}) микросхем в режимах и условиях установленных в ТУ, 100000 ч., а в следующих облегченных режимах и условиях при: U_{св} ≤ 12 В; P_{tot.max} ≤ 40 мВт – 120000ч.

Гамма-процентный ресурс (Г_р) микросхем при γ=95% 200000 ч

Минимальный срок сохраняемости микросхем (Т_{см}) при их хранении:
- в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемой влажностью и температурой или местах хранения микросхем, смонтированных в защищенную аппаратуру, или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, - 25 лет;
- в неотапливаемом хранилище – 16,5 лет;
- под навесом и на открытой площадке, смонтированными в аппаратуру (в составе незащищенного объекта), или в комплекте ЗИП – 12,5 лет.
Срок сохраняемости исчисляется с даты изготовления, указанной на микросхеме.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых микросхем всем требованиям АЕЯР.431410.455 ТУ, а микросхем с индексом «ОСМ» - АЕЯР.431410.455 ТУ и ПО.070.052 в течение срока сохраняемости и минимальной наработки в пределах срока сохраняемости при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и эксплуатации, а также указаний по применению, установленных ТУ.

Срок гарантии исчисляется с даты изготовления, нанесенной на микросхеме.

Н о р м а

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения

Буквенное обозначение

159НТ1АСВК 159НТ1АС1ВК 159НТ101АСВК 159НТ101АС1ВК ОСМ159НТ1АС1ВК ОСМ159НТ101АС1	159НТ1БСВК 159НТ1БС1ВК 159НТ101БСВК 159НТ101БС1ВК ОСМ159НТ1БС1ВК ОСМ159НТ101БС1	159НТ1ВСВК 159НТ1ВС1ВК 159НТ101ВСВК 159НТ101ВС1ВК ОСМ159НТ1ВС1ВК ОСМ159НТ101ВС1	159НТ1ГСВК 159НТ1ГС1ВК 159НТ101ГСВК 159НТ101ГС1ВК ОСМ159НТ1ГС1ВК ОСМ159НТ101ГС1	159НТ1ДСВК 159НТ1ДС1ВК 159НТ101ДСВК 159НТ101ДС1ВК ОСМ159НТ1ДС1ВК ОСМ159НТ101ДС1	159НТ1ЕСВК 159НТ1ЕС1ВК 159НТ101ЕСВК 159НТ101ЕС1ВК ОСМ159НТ1ЕС1ВК ОСМ159НТ101ЕС1
--	--	--	--	--	--

не менее	не более												
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Модуль разности прямых напряжений база-эмиттер, мВ, при: I _Е =1,00 мА	?U _{BE1} - U _{BE2} ?	-	3	-	3	-	3	-	10	-	10	-	10
Прямое падение напряжения база-эмиттер транзистора, В, при: I _Е =1,00 мА	U _{BE SAT}	0,55	0,75	0,55	0,75	0,55	0,75	0,55	0,75	0,55	0,75	0,55	0,75
Обратный ток коллектора, мкА, при U _{CB} = 20 В	I _{СВО}	-	0,01	-	0,01	-	0,01	-	0,01	-	0,01	-	0,01
Обратный ток эмиттера, мкА, при U _{BE} = 4 В	I _{ЕВО}	-	0,03	-	0,03	-	0,03	-	0,03	-	0,03	-	0,03
Обратный ток коллектора - эмиттера мкА, при U _{CE} =20 В, R _В = 10 ⁴ Ом	I ¹ _{КЭ}	-	0,03	-	0,03	-	0,03	-	0,03	-	0,03	-	0,03
Ток утечки между транзисторами, мкА, при: U _Г =25 В	I _Г	-	0,01	-	0,01	-	0,01	-	0,01	-	0,01	-	0,01
Статический коэффициент прямой передачи тока в режиме большого сигнала, при: I _Е = 1,00 мА	h _{21E}	30	90	60	180	-	-	30	90	60	180	-	-
Статический коэффициент прямой передачи тока в режиме большого сигнала, при: I _Е = 0,05 мА	h _{21E}	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	80	-
Отношение статических коэффициентов прямой передачи тока в режиме большого сигнала, при: I _Е = 1,00 мА I _Е = 0,05 мА	h _{21E1} h _{21E2}	0,90 -	- -	0,90 -	- -	- 0,92	- -	0,80 -	- -	0,80 -	- -	- 0,80	- -
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте, при: I _Е = 3,00 мА, f = 10 ⁸ Гц	?h _{21E} ?	2,5	-	2,5	-	2,5	-	2,5	-	2,5	-	2,5	-

Остальной режим измерения при: U_{CB} = 5 В
Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем:
- золото
Цветных металлов не содержится.